

Na osnovu čl. 128. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 129. Statuta TMF-a, na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 22.05.2014. godine, doneta je

O D L U K A

o prihvatanju Referata o oceni doktorske disertacije

Prihvata se Referat Komisije u sastavu: dr Rajko Šašić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, dr Boris Lončar, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, dr Stanko Ostojić, vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, dr Petar Lukić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, dr Svetlana Pelemiš, docent Tehnološkog fakulteta u Zvorniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, o pregledu i oceni urađene doktorske disertacije pod nazivom: „SILICIJUMSKI I SILICIJUM-KARBIDNI UNIPOLARNI TRANZISTORI SPECIFIČNIH GEOMETRIJA“ koju je podneo **mr ABED ALHKEM ALKOASH**, dipl. inž., i upućuje se na saglasnost Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Veće naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu dalo je saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Abed-a Alhkem-a Alkoash-a pod nazivom „SILICIJUMSKI I SILICIJUM-KARBIDNI UNIPOLARNI TRANZISTORI SPECIFIČNIH GEOMETRIJA“ Odlukom 02 broj: 61206-118/2-14 od 20.01.2014. godine.

Verifikacija naučnih doprinosa:

Kategorija M22

1. **Alkoash Abedalkhem**, Sasic Rajko M., Ostojic Stanko M., Lukic Petar M., „An Improvement of Analytical *I-V* Model for Surrounding-Gate MOSFETs”, *Journal of Computational and Theoretical Nanoscience*, **8**, 1, 2011, pp. 47-50(4), (IF=0.912, 2011.), DOI: 10.1166/jctn.2011.1657, ISSN 1546-1955, Online ISSN: 1546-1963
2. **Abdel Alkhem**, Rajko M. Sasic, Petar M. Lukic and Stanko M. Ostojic. “4H-SiC VDIMOS drift region: energy aspects of its formation and analysis”, *Physica Scripta*, vol. 89, br. 1, 2014 (IF=1.032, 2012.), ISSN 0031-8949 (Print), ISSN 1402-4896 (Online)

Kategorija M23

1. Sasic Rajko M., Lukic Petar M., Ostojic Stanko M., **Alkoash Abedalkhem**, “The influence of quantum effects on spatial distribution of carriers in surrounding – gate cylindrical MOSFETs”, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, **12**, 5, 2010, pp. 1161-1164, (IF=0.577, 2008.) ISSN: 1454-4164
2. Abood Imhammad, Lukic Petar M., Sasic Rajko M., **Alkoash Abed Alkhem**, Ostojic Stanko M., “4H-SiC VDMOS - drift-region saturation, channel saturation and their order of appearance”, *Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications*, vol. 7 No. 5-6, 2013, pp. 329-333, (IF=0.402, 2012.) ISSN: 1454-4164, ISSN: Print: 1842-6573

Izveštaj o oceni doktorske disertacije dostavlja se na uvid javnosti, a po isteku roka od 30 dana, na saglasnost Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Odluku dostaviti: Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta, doktorantu, Službi za nastavno-studentske poslove, Biblioteci i Arhivi fakulteta.

D E K A N

Prof. dr Đorđe Janačković